ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE

Patent number:

JP5247460

Publication date:

1993-09-24

Inventor:

ONISHI TOSHIHIRO; others: 02

Applicant:

SUMITOMO CHEM CO LTD

Classification:

- international:

C09K11/06; C08G61/00; H05B33/14

- european:

Application number:

JP19920300903 19921111

Priority number(s):

Abstract of JP5247460

PURPOSE: To provide the title device which gives a high luminance at a low driving voltage by forming a luminescent layer contg. an electron-transporting compd. and a luminescent material comprising a specific substd. poly(p- phenylenevinylene) between a pair of electrodes.

CONSTITUTION: The title device is produced by forming a luminescent layer contg. an electron-transporting compd. [e.g. 2-(4-biphenylyl)-5-(4-t-butylphenyl) 1,3,5-oxadiazole] and a high-molecular luminescent material of the formula (wherein R1, R2, R3, and R4 are each B, 1-20C alkyl, alkoxy, alkylthio, or a 6-20C arom. hydrocarbon group provided that at least one of them is 4-20C alkyl, alkoxy, or alkylthio; and n is 5 or higher) between a pair of electrodes at least one of which is transparent or translucent.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

I HIS PAGE BLANK (USPTO)

Family list 3 family members for: JP5247460 Derived from 2 applications.

Back to JP524

- 1 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE Publication info: JP3328731B2 B2 - 2002-09-30 JP5247460 A - 1993-09-24
- 2 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: JP2002319493 A 2002-10-31

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頗公開沿号

特開平5-247460

(43)公開日 平成5年(1993)9月24日

(51) Int.CL

識別記号

FI

技術表示簡所

C 0 9 K 11/06

Z 6917-411

广内整理番号

C 0 8 G 61/00

NLF 8215-4 J

H 0 5 B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁)

(21)出願番号

特顏平4…300903

(22)出願官

平成4年(1992)11月11日

(31) 優先権主張番号 特願平3-321976

(32) 優先日二

平3(1991)12月5日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(31)優先権主張番号

特願平4-2124

(32)優先日

平4 (1992) 1月9日

(33) 優先権主張国

日本(JP)

(71) 出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4 1 门 5 番33号

(72)発明者 大西 敏博

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(72)発明者 野口 公信

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(72) 発明者 土居 秀二

茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式

会社内

(74)代理人 介理士 久保山 隆 (外1名)

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

[目的] 低電圧駆動で、しかも輝度が向上した有機エレ クトロルミネッセンス素子を提供する。

【構成】少なくとも一方が透明または半透明である一対 の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層 を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、 該発光層が下記化工

(化1)

(式中、Ri、Ri、Ri、Riはそれぞれ独立に水 素、炭素数1~20のアルキル基、アルコキシ基および アルキルチオ基ならびに炭素数6~20の芳香族炭化水 素基から選ばれた基を示し、且つ少なくとも一つが炭素・ 数4~20のアルキル基、アルコキシ基またはアルキル チオ基であり、nは5以上の数を表す。)で表される置 換ポリ (p ソェニレンピニレン)と電子輸送性化合物

を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス 素了。

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層が下記化1

(化1)。

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_2 \\
\hline
R_3 & R_4
\end{array}$$
CH = CH

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 はそれぞれ独立に水素、炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、アルコキシ基およびアルキルチオ基ならびに炭素数 $6\sim 20$ の芳香族炭化水素基から選ばれた基を示し、自つ少なくとも一つが炭素数 $4\sim 20$ のアルキル基、アルコキシ基またはアルキルチオ基であり、n は 5 以上の数を表す。)で表される置換ボリ(p-7 エニレンビニレン)と電子輸送性化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表子

【請求項2】少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に少なくとも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層が化1で表される置換ポリ(pーフェニレンビニレン)よりなり、且つ陰極と該発光層との間に、該発光層に隣接して電子輸送性化合物からなる層を設けたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子

【請求項3】陰極がMgとAgの合金からなることを特徴とする請求項1または2記載の有機エレクトロルミネ 30 ッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

(0001)

【産業1の利用分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子(以下有機EL素子)に関するものである。 詳しくは、置換ボリ(p-フェニレンビニレン)を発光材料として用いた有機EL素子に関する。

(0002)

【従来の技術】従来から用いられている無機エレクトロルミネッセンス素子は発光させるのに高電圧が必要であれた。最近、Tangらは有機蛍光色素を発光層とし、それに電子写真の感光体等に用いられていた有機電荷輸送化合物を積層した工層構造を有する有機EL素子を作製し、発光層のみを有するものに比較して低電圧駆動、高効率、高輝度の有機EL素子を実現させた(特開昭59194393号公報)。有機EL素子は無機EL素子に比べ、低電圧駆動、高輝度に加えて多数の色の発光が容易に得られるという特長があることから、素子構造や有機強光色素、有機電荷輸送化合物について多くの試みが報告されている「ジャパニーズ・ジャーナル・オブラの

・アプライド・フィジックス(Jpn. J. Appl. Phys.) 27巻、L269(1988年))、(ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス(J. Appl. Phys.) 65巻、3610頁(1989年))。これまでに、発光材料としては低分子量の有機強光色素が一般に用いられており、高分子量の発光材料としては、WO9013148号公開明細書、特開平3-126787号公報、アプライド・フィジックス・レターズ(Appl. Phys. Lett.)58巻、19

[0003]

った。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これまで報告されてきた高分子発光材料を用いた有機EL素子は駆動電圧が高く、輝度も必ずしも十分とは言い難いものであった。高分子発光材料は熱的に安定であり、また途布法により容易に均一性に優れた発光層を形成できることから、それらの長所を生かしながら、より駆動電圧が低く、高輝度である有機EL素子が要望されている。

【0004】本発明の目的は高分子発光材料を発光層とした低電圧駆動、高輝度の有機EL素子を提供することにある。

[0005]

20

【課題を解決するための手段】本発明者等は、高分子発 光材料を発光層として用いた有機EL素子の低電圧駅 動、高輝度化を鋭意検討してきた。その結果、高分子発 光材料として、置換ポリーpーフェニレンビニレンを用 い、これに、電子輸送性化合物を添加したものを発光層 として用いるか、または、高分子発光層と陰極との間に 高分子発光層に隣接して電子輸送性化合物の層を形成す ることにより、高分子発光材料を単独で用いた場合に比 べて、低電圧駆動化、高輝度化が実現されることを見い 出し、本発明に至った。

【0006】すなわち、本発明は、少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層が下記化2

[0007]

【化2】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

高効率、高輝度の有機EL素子を実現させた(特開昭5 9 194393号公報)。有機EL素子は無機EL素 炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、アルコキシ基および アルキルチオ基ならびに炭素数 $6\sim20$ の芳香族炭化水 が容易に得られるという特長があることから、素子構造 や有機強光色素、有機電荷輸送化合物について多くの試 タイ〜20 のアルキル基、アルコキシ基またはアルキル みが報告されている(ジャパニーズ・ジャーナル・オブ 50 チオ基であり、n は5以上の数を表す。)で表される尚

--176--

換ポリ (p フェニレンピニレン) と電子輸送性化合物 を含むこと、あるいは該発光層が上記化2で表される質 換ポリ(ローフェニレンピニレン)よりなり、且つ該発 ・光層と陰極の間に該発光層に隣接して電子輸送性化合物 の層を設けることを特徴とする有機EL素子を提供する

- 【0008】以下、本発明の有機EL素子について詳細 に説明する。本発明に用いられる上記化2で表わされる 置換ポリ (p-フェニレンピニレン) は溶剤に可溶性の ものである。ここで、R: 、R2 、R3 、R2 はそれぞ 10 れ独立に水素、炭素数1~20のアルキル基、アルコキ ・基およびアルキルチオ基ならびに炭素数6~20の芳 香族炭化水素基から選ばれた基を示し、且つ可溶性を与 えるには、少なくともそれらの一つが炭素数4~20の。 アルキル基、アルコキシ基またはアルキルチオ基である ことが必要である。これらのなかで成膜性が良好なアル キル基、アルコキシ基が特に好ましい。ここで、炭素数 1~20のアルキル基としては、例えば、メチル基、エ チリ基、プチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル 基、オクチル基、デシル基、ラウリル基、2 - エチルー ヘキシル基、3 - メチル・プチル基、イソプロピル基な どであり、ペンチル基、ヘキシル基、ヘブチル基、オク チル基、テシル基、2 エチルーヘキシル基、3-メチ ル フチル基が好ましい。または炭素数1~20のアル - コキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プトキシ 基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオ キシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基、ラウリル オキシ基、2-エチルーヘキシルオキシ基、3-メチル ープトキシ基、イソプルピルオキシ基などであり、ペン チルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、 30 オクチルオキシ基、デシルオキシ基、2-エチルーへキ シルオキシ基、3-メチループトキシ基が好ましい。ア ルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、 プラルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘブ チルチャ基、オクチルチオ基、デシルチオ基、ラウリル チャ基、2。エチルーヘキシルチオ基、3~メチループ チルチで基、イソプルピルチオ基などであり、ペンチル チで基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチ | 才基、デシルチオ基、2-エチル-ヘキシルチオ基、3 - メチル・ブチルチオ基が好ましい。芳香族炭化水素基 40 としてはフェニル基、4-アルコキシフェニル基、4-アルキルフェニル基、1ーナフタレン基、2ーナフタレ ン基が例示される。

【0009】具体的な價換ポリ(p-フェニレンピニレ シ)としては、ポリ(2、5ージベンチルーローフェニ シンピニレン)、ポリ(2,5-ジヘキシルーp-フェー ニレンピニレン)、ポリ(2,5-ジヘプチルーローフ・ ニニレンピニレン)、ポリ(2,5-ジオクチルーpー **-フェニレンピニレン)、ポリ(2.5-ジデシル-p-**フェニレンビニレン)、ポリ(2,5 ジベンチルオキ 50 なわち、例えば、相当するピス (ハロゲン化メチル)化

シーpーフェニレンピニレン)、ポリ(2,5 ジヘキ シルオキシーpーフェニレンピニレン)、ボリ(2,5 -ジヘプチルオキシ-p-フェニレンビニレン)、ボリ (2,5-ジオクチルオキシーローフェニレンビニレ ン)、ポリ(2,5 ジデシルオキシ p フェニレン ビニレン)、ポリ(2,5-ジペンチルチオーローフェ ニレンピニレン)、ポリ(2、5-ジヘキシルチオーゥ -フェニレンピニレン)、ポリ(2,5-ジヘプチルテ オーローフェニレンピニレン)、ポリ(2-メトキシー 5-ヘプチルオキシーp-フェニレンピニレン)、ポリ (2-メトキシー5-ラウリルオキシーp-フェニレン ピニレン)、ポリ(2-メトキシ-5-(2 -エチル - ヘキシルオキシ) - p - フェニレンピニレン) 、ポリ (2-メトキシー5-ヘプチルチオーカーフェニレンピ ニレン)、ポリ(2-メトキシー5-ラウリルチオーカ ーフェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシ・5 (3'-メチループトキシ)ー pーフェニレンビニレ ン) などが例示される。これらの中で、ポリ (2.5-ジペンチルーpーフェニレンピニレン)、ポリ(2.5 ージヘキシルーp…フェニレンビニレン)、ポリ(2, 5-ジヘプチル-p-フェニレンピニレン)。ポリ (2, 5-3777)リ(2,5-ジペンチルオキシ-p-フェニレンピニレ ン)、ポリ(2,5-ジヘキシルオキシーカーフェニレ ンピニレン)、ポリ(2,5-ジヘプチルオキシーp-フェニレンピニレン)、ポリ(2,5-ジオクチルオキ シーpーフェニレンビニレン)、ポリ(2,5 ジデシ ルオキシーp-フェニレンピニレン)、ボリ (2-メト キシー5-ヘキシルオキシーカーフェニレンピニレ ン)、ポリ(2-メトキシ-5-(3'-メチループト キシ) - p - フェニレンピニレン) が好ましい。これら の置換ポリ(p-フェニレンピニレン)は単独で用いて もよいし、2種類以上を混合して用いてもよい。

【0010】化2において、nは繰り返し単位の数を表 し、5以上であれば特に限定されないが、余りにも小さ すざると均一な膜が得られにくい場合があり、また、余 りに大きすぎても溶解性が低下し、均一に製膜すること が困難になる場合があるのでnの範囲は10~3000 0が好ましく、10~10000がより好ましい。

【0011】これらの有機溶媒可溶性の置換ポリ (p-フェニレンピニレン) を用いることにより、溶液から成 膜する場合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去す るだけでよく、また、電子輸送性化合物を混合した場合 においても同様な手法が適用でき、製造上非常に有利で

【0012】上記化2で示される置換ポリ(ローフェニ レンピニレン)の合成法としては特に限定されないが、 例えば特開平1-254734号公報、特開平1-79 217号公報等に記載されている方法が用いられる。す 合物、より具体的には、例えば、2、5-ジヘプチルオ キシーpーキシリレンジプロミドを、キシレン/第三級 ブチルアルコール混合溶媒中、第三級プトキシカリウム を用いて重合させる脱ハロゲン化水素法をあげることが できる。また、相当するホスホニウム塩とアルデヒドと をリチウムアルコラートを触媒として反応させる方法で あるwittig法、相当するスルホニウム塩をアルカ り存在下に重合させ、ついで脱スルホニウム塩処理を行 なうスルボニウム塩分解法などが例示される。また、こ れらの高分子化合物を有機EL素子の発光層として用い る場合、その純度が発光特性に影響を与えるため、合成 後、再沈精製、クロマトグラフによる分別等の純化処理 をすることが望ましい。

【0013】本発明に用いられる電子輸送性化合物とし ては、発光材料として使用する置換ポリ(p-フェニレ ンドニレン) に対して電子輸送性が高ければ特に限定さ れないが、例えば、オキサジアゾール系化合物、ペンゾ キノン系化合物、ナフトキノン系化合物、アントラキノ ン系化合物、テトラシアノアンスラキノジメタン系化合 物、ジフェニルジシアノエチレン系化合物、フルオレノ ン系化合物、ジフェノキノン系化合物、8 - ヒドロキシ キノリンおよびその誘導体の金属錯体等が例示される。 具体的には、特別昭63-70257、同63-175 860号公報、特開平2-135361、同2-135 359、同3-152184号公報に記載されているも の等、公知のものが使用可能であるが、オキサジアゾー ル系化合物、ベンソキノン系化合物、アントラキノン系 化合物、8 。ヒドロキシキノリンおよびその誘導体の金 | 減鉛体が好ましく、特に、2-(4-ピフェニリル)-5 - (4-t-ブチルフェニル) -1.3,4-オキサ 30 ジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス (8-4/リノール) アルミニウムが好ましい。これら の電子輸送性化合物は、単独で用いてもよいし、2種類 以上を混合して用いてもよい。電子輸送性化合物を置換 ボリ (p フェニレンピニレン) に混合して使用する場 合、その量は少なすぎると効果が小さく、多すぎると発 光に寄与しない電流が増加するため、有機EL素子にし た場合、輝度等の特性が悪くなる。使用する電子輸送性 化台物の分子量によっても異なるが、混合する割合は長 鎖基置換ポリ (p-フェニレンピニレン) に対して1~ 40 4.0 w t %が好ましく、より好ましくは2~30wt% である。

【0014】本発明においては、化2で示される置換ポ リ (pーフェニレンビニレン) に、既知の発光材料を分 散させたものを発光層として用いることも含まれる。発 光材料としては特に限定されないが、例えば、ナフタレ ン誘導体、アントラセン及びその誘導体、ペリレン及び その誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン 系、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリン およびその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフ 50 子化合物としては、特に限定されないが、電荷輸送を極

ェニルシクロペンタジエン及びその誘導体、テトラフェ ニルブタジエン及びその誘導体などを用いることができ る。具体的には、例えば特開昭57-51781、同5 9-194393号公報に記載されているもの等、公知 のものが使用可能である。

[0015] 本発明の有機EL素子の構造について以下 に述べる。陽極および陰極からなる一対の電極で、透明 または半透明な電極としては、ガラス、透明プラスチッ ク等の透明基板の上に透明または半透明の電極を形成し たものが用いられる。陽極の材料としては、導電性の金 属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的 にはインジウム・スズ・オキサイド (1 TO)、酸化ス ズ (NESA)、Au、Pt、Ag、Cu等が用いられ る。作製方法としては真空蒸着法、スパッタリング法、 メッキ法などが用いられる。

【0016】次いで、この陽極上に置換ポリ(ローフェ ニレンビニレン)と電子輸送性化合物を含む発光層を形 成する。成膜方法としてはこれら材料の混合液を使用し てスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピ ング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法また は真空蒸着法が例示されるが、混合溶液をスピンコーテ ィング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコ --ト法、ロールコート法等の塗布法により成膜するのが 特に好ましい。

【0017】発光層の膜厚としては5A~10 µm、好 ましくは10A~1μmである。電流密度を上げて発光 効率を上げるためには100~5000人の範囲が好ま しい。なお、塗布法により薄膜化した場合には、溶媒を 除去するため、減圧下あるいは不活性雰囲気ド、室温以 上で材料の分解温度以下、具体的には30~330℃、 好ましくは60~300℃、さらに好ましくは100~ 250℃の温度で熱処理することが望ましい。熱処理す る時間としては、溶媒を除去するためには少なくとも1 0分以上処理することが好ましく、実用的には1~24 時間がより好ましい。

【0018】また、別の態様である発光層が電子輸送性 化合物を含まない場合には上記の成膜方法で発光層を設 け、その上に電子輸送層を形成する。電子輸送層の材料 としては前述の電子輸送性化合物が用いられる。

【0019】電子輸送性化合物の成膜方法としては、特 に限定されないが、粉末状態からの真空蒸着法、あるい は溶媒に溶かした後のスピンコーティング法、キャステ ィング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコー ト法等の塗布法、あるいは上記化2の長鎖基置換ポリ (p-フェニレンピニレン) またはそれとは別の高分子 化合物と電子輸送性化合物とを溶液状態または溶融状態 で混合し分散させた後のスピンコーティング法、キャス ティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコ **一ト法等の塗布法を用いることができる。混合する高分** 度に印書しないものが好ましく、また、可視光に対する
吸収が強くないものが好適に用いられる。例えば、上記
化2の長鎖基置換ポリ(pーフェニレンビニレン)、ポリ (2,5 ージメト
キシーp・フェニレンビニレン)、ポリ (2,5 ージメ
チルーp・フェニレンビニレン)、ポリチオフェン及び
その誘導体、ポリ (2,5 ーチエニレンビニレン) 及び
その誘導体、ポリカーボネート、ポリメタクリレート、
ポリメチルメタクリレート、
ポリメチルメタクリレート、
ポリメチルスタクリレート、
ポリスチレン、
ポリメルカーボネート
北リスチレン、
ポリメルカーボネート
北リスチレン
ポリメルカーボネート
北リスチレン
ポリスチレン
ポリスチレン
北リスチレン
北リストレン
北上レン
北上レン

【0.020】電子輸送層の膜厚は、少なくともピンホールが発生しないような厚みが必要であるが、あまり厚いと素子の抵抗が増加し、高い駆動電圧が必要となり好ましくない。したがって、電子輸送層の膜厚は $5\,\Lambda\sim1.0\,\mu$ m、好ましくは $1.0\,\Lambda\sim1\,\mu$ m、さらに好ましくは $5.0\sim2.0\,0\,0\,\Lambda$ である。

【0021】次いで、発光層が置換ボリ(pーフェニレンビニレン)と電子輸送性化合物との混合層の場合はこの層の上に、また発光層と電子輸送層が積層されている場合は電子輸送層の上に電極を設ける。この電極は電子注入陰極となる。その材料としては、特に限定されないが、イオン化エネルギーの小さい材料が好ましい。例えば、Al、ln、Mg、MgとAgの合金(MgーAg合金と記載することがある)、In-Ag合金、Mgーln合金、グラファイト薄膜等が用いられる。これらの中ではMgとAgの合金が好ましい。陰極の作製方法としては真空蒸着法、スパッタリング法等公知の方法が用いられる。

【0022】なお、本発明のEL素子の構造としては、 これまで述べた陽極/発光層/陰極(/は層を積層した ことを示す)、あるいは陽極/発光層/電子輸送層/陰 極の構造以外に、陽極と発光層の間、または陰極と電子 輸送層との間に高分子化合物のバッファー層を有する組 み合わせの構造、すなわち陽極ノバッファー層/発光層 / 陰極、陽極/パッファー層/発光層/電子輸送層/陰 極、陽極/発光層/パッファー層/陰極、陽極/発光層 /電子輸送層/バッファー層/陰極、陽極/バッファー 周/発光層/バッファー層/陰極、陽極/パッファー層 40 / 発光層/ 電子輸送層/バッファー層/陰極をとること もできる。バッファー層に用いる高分子化合物としては 特に限定されないが、電荷輸送を極度に阻害しないもの が好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないもの が好適に用いられる。例えば、ボリ(Nーピニルカルバ ソール)、ポリアニリン及びその誘導体、ポリチオフェ ン及びその誘導体、ポリ(2,5-チエニレンピニレ ン)及びその誘導体、ポリシラン及びその誘導体などが 例示される。成膜が容易に行なえるという点では、釜布 法を用いることが好ましい。バッファー層の厚みは通常 50

5 A ~ 1 0 μm、電流密度を上げて発光効率を上げるためには好ましくは 1 0 ~ 5 0 0 0 A、より好ましくは 2 0~1000 Aである。

[0023]

【実施例】以下本発明の実施例を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0024】実施例1

スパッタリングによって、200人の厚みでITO膜を 付けたガラス基板に、特開平1-79217号公報の実 施例6で2,5-ジへプチルーp-キシリレンジプロミ ドの代わりに 2, 5 - ジヘプチルオキシー p - キシリレ ンジブロミドを用いて実施例6記載の方法で合成したポ リ(2,5-ジペプチルオキシ-p-フェニレンビニン ン) (ゲルパーミエーションクロマトグラフ (GPC) によるポリスチレン換算の数平均重合度約360)と前 子翰送性化合物として2-(1-ビフェニリル) 5 (4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジア ゾール〔ポリ(2、5 - ジヘプチルオキシー p - フェニ レンピニレン) に対する混合割合は5wt%) の0.6 7wt%トルエン/クロロホルム(3/2重量比)溶液 を用い、スピンコートにより800人の厚みで成膜し た。次いで、これを減圧下60℃で1時間乾燥した後、 その上に陰極として、Inを3000人蒸着して、有機 EL素子を作製した。蒸着のときの真空度は3×10⁻⁵ Torr以下であった。この素子に電圧19. 4 Vを用 加したところ、電流密度275mA/cm²の電流が流 れ、輝度160、6cd/m゚のオレンジ色のEL発光 が観察された。また20cd/m゚の輝度にするための 電圧は13.2Vであった。

30 【0025】実施例2

0 【0026】実施例3

2- (4-ピフェニリル) -5- (4-t-ブチルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾールをポリ (2, 5-ジヘプチルオキシーp-フェニレンピニレン) に対して2.5 w t %とした以外は実施例1と同じ方法で1010人の厚みの発光層を持つ、有機Eし素子を作製した。この素子に地圧19、4 Vを印加したところ、電流密度56 m A / c m²の電流が流れ、輝度46、8 c d / m²のオレンジ色のE L 発光が観察された。また20cd/m²の輝度にするための電圧は17.5 Vであっ

9

【0027】比較例1

【0028】実施例4

ボリ (2. 5-ジヘプチルオキシーp-フェニレンビニ レン)の代わりに、特開平1-79217号公報の実施 例6で2、5-ジヘプチル-p-キシリレンジブロミド の代わりに2.5 ジヘキシルオキシー pーキシリレン ジプロミドを用いて実施例6記載の方法で合成したポリ (2. 5 - ジペキシルオキシーカーフェニレンビニレ ン) (GPCによるポリスチレン換算数平均重合度約1 6.0) を用い、2 (4 ビフェニリル) - 5 - (4 t ブチルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール をポリ(!!, 5 - ジヘキシルオキシー p - フェニレンビ ニレン)に対して10wt%混合し、溶媒としてクロロ ホルムを用いた以外は実施例1と同じ方法で1300Å の厚みの発光層を持つ、有機EL素子を作製した。この 素子に電圧25、0 Vを印加したところ、電流密度34 6 mA/cm/ の電流が流れ、輝度44..6 c d/m² のオレンジ色のEL発光が観察された。また20cd/ m の輝度にするための電圧は23,5Vであった。

【0029】実施例5

ポリ(2,5)ジヘプチルオキシ p フェニレンビニ レン)の代わりに、特開平1-79217号公報の実施 例6で2,5-ジへプチル-p-キシリレンジブロミド の代わりに2、5ージベンチルオキシーpーキシリレン ジブロミドを用いて実施例6記載の方法で合成したポリ (2.5 - ジペンチルオキシーpーフェニレンピニレ ン) (GPCによるポリスチレン換算数平均重合度約4 00) を用い、2-(4-ピフェニリル) -5-(4-1-ブチルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアソール をボリ (2, 5 - ジベンチルオキシー p - フェニレンビ コレン) に対して 10 w t %混合し、溶媒としてクロロ ポリムを用いた以外は実施例1と同じ方法で1400A の厚みの発光層を持つ、有機EL素子を作製した。この 素子に電圧23.3Vを印加したところ、電流密度38 6 m A / c m² の電流が流れ、輝度 5 1 . 4 c d / m² のオレンジ色のEL発光が観察された。また20cd/ m² の輝度にするための電圧は22.5Vであった。

【0030】比較例2

ージヘブチルオキシーpーフェニレンビニレン)に対して44.4wt%混合した以外は実施例1と同じ方法で2600人の厚みの発光層を持つ、有機11.素子を作製した。この素子に電圧40.0Vを印加したところ、電流密度1360mA/cm²の電流が流れたが、輝度13.4cd/m²のオレンジ色のドレ発光が観察されただけであった。また電圧を上げると絶縁破壊のため20cd/m²の輝度にすることができなかった。

【0031】 実施例6

スパッタリングによって、200人の厚みで1丁〇膜を 付けたガラス基板に、実施例1と同様の方法で合成した ポリ(2,5-ジヘプチルオキシーp-フェニレンビニ レン) と電子輸送性化合物としてアントラキノン (ボリ (2.5-ジへプチルオキシーp-フェニレンピニレン に対する混合割合は5wt%)の(). 67wt%トルエ ン/クロロホルム(3/2重量比)溶液を用い、スピン コートにより1100人の厚みで成膜した。次いで、こ れを減圧下60℃で1時間乾燥した後、その上に陰極と して、Inを3000人蒸着して、有機EL素子を作製 した。蒸着のときの真空度は3×10-6Torr以下で あった。この素子に電圧20.8Vを印加したところ、 電流密度165.2mA/cm²の電流が流れ、輝度1 46 c d/m² のオレンジ色のE L 発光が観察された。 また、20cd/m²の輝度にするための電圧は16. 8 Vであった。

【0032】 実施例7

1 TO膜上にバッファー層としてポリ(2,5) チェニ レンピニレン)とポリ(pーフェニレンピニレン)の 7:3 (重量比) の混合物から成る層をつけた以外は、 発光層、陰極は実施例6と同じ方法で、バッファー層と 発光層の厚さの合計が1500人の有機EL素子を作製 した。ここで、ポリ(2,5-チエニレンビニレン)と ポリ (p-フェニレンピニレン) の7:3の混合物から 成る層は、特開平1-9221号公報の実施例1に記載 の方法で得たポリ (2, 5-チエニレンビニレン) (P TV) 中間体をN, Nージメチルホルムアミド(DM F)に溶解してPTV中間体溶液としたものと、特別昭 59-199746号公報の実施例1に記載の方法で合 成したポリ (p-フェニレンピニレン) (PPV) 中間 体のBr 塩の水溶液を大量のNaBFa水溶液に添加 して対イオン (Br-) をBFa- に交換し、沈澱とし て回収したPPV中間体のBF4 塩をDMFに溶解し てPPV中間体溶液としたものを、熱処理後生成する両 高分子の重量比が7:3となるような割合で混合した溶 液をスピンコートにより成膜し、200℃で熱処理する ことにより作成した。この素子に電圧24、 1 V を印加 したところ、電流密度70.8mA/cm²の電流が流 れ、輝度120cd/m²のオレンジ色のEL発光が観 察された。また、20cd/m²の輝度にするための電 11

【0033】実施例8

アントラキノンの代わりにベンゾキノンを混合した以外 は実施例6と同じ方法で630人の厚みの発光層を持 つ、有機EL素子を作製した。この素子に電圧18.3 Vを印加したところ、電流密度163...4mA/cm² の電流が流れ、輝度63cd/m¹のオレンジ色のEL 発光が観察された。また、20cd/m2の輝度にする ための地圧は14、8 Vであった。

【0034】 実施例 9

実施例1と同じ方法で1TO膜を付けたガラス基板に、 「実施例」と同じ方法で合成したポリ(2,5ージヘプチ ルオキシ pーフェニレンビニレン) (ゲルパーハエー) ションクロマトグラブ (GPC) によるポリスチレン換 算の数平均重合度約360)の0.75wt%クロロホー ルム溶液を用い、ディッピングにより成膜した。つい で、これを減圧下60℃で1時間乾燥した後、その上に 電子輸送層として、トリス(8-キノリノール)アルミ ニウムを700A蒸着し、ついで陰極として、Mg-A g 合金 (重量比10:1) を1500A、さらにその上 にAgを1000A蒸着して、有機EL素子を作製し 20 能である。 た、有機層の厚さは合計910人であった。また、蒸着

のときの真空度はいずれも3×10-6Torr以下であ った。この素子に電圧17、8 Vを印加したところ、電 流密度420mA/cm2の電流が流れ、輝度2290 cd/m²のオレンジ色のEL発光が観察された。発光 スペクトルはポリ(2,5-ジヘプチルオキシー)-フ エニレンピニレン)の蛍光スペクトルと一致した。

【0035】比較例3

電子輸送層を設けない以外は、実施例9と同じ方法で有 機EL素了を作製した。この素子に電圧9. 2 Vを印加 10 したところ、電流密度 5 6 9 m A / c m² の電流が流 れ、輝度1189cd/m²のオレンジ色のEL発光が 観察された。また、これ以上電圧を上げても輝度は向上: せず、11.7 Vで素子の破壊のため発光しなくなっ た。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の有機下工 素子は、従来のものと比較して、低電圧駆動で、しかも 輝度が向上しており、バックライトとしての面状光源、 フラットパネルディスプレイ等の装置としての使用が可 THIS PAGE BLANK (USPTO)